Высокая стойкость к электротермоциклированию
Низкие статические и динамические потери
Разработан для промышленного применения

Полупроводниковый Элемент Низкочастотного Диода Тип DR100-3200-65

Максимально допустимый средний прямой ток[1)]		I_{FAV}	3200 А
Повторяющееся импульсное обратное напряжение		U_{RRM}	6200...6500 В
U_{RRM}, В	6200	6400	6500
Класс по напряжению	62	64	65
T_j, °C	–60...+150		

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ

Обозначение и наименование параметра		Ед. изм.	Значение	Условия измерения	
Параметры в проводящем состоянии					
I_{FAV}	Максимально допустимый средний прямой ток[1)]	А	3200 3750	T_c=111 °C; двухстороннее охлаждение; T_c=100 °C; двухстороннее охлаждение; 180 эл. град. синус; 50 Гц	
I_{FRMS}	Действующий прямой ток[1)]	А	5024	T_c=111 °C; двухстороннее охлаждение; 180 эл. град. синус; 50 Гц	
I_{FSM}	Ударный ток[1)]	кА	64.0 74.0	T_j=$T_{j\,max}$ T_j=25 °C	180 эл. град. синус; t_p=10 мс; единичный импульс; U_R=0 В;
			67.0 77.0	T_j=$T_{j\,max}$ T_j=25 °C	180 эл. град. синус; t_p=8.3 мс; единичный импульс; U_R=0 В;
I^2t	Защитный показатель[1)]	$A^2c\cdot10^3$	20400 27300	T_j=$T_{j\,max}$ T_j=25 °C	180 эл. град. синус; t_p=10 мс; единичный импульс; U_R=0 В;
			18600 24600	T_j=$T_{j\,max}$ T_j=25 °C	180 эл. град. синус; t_p=8.3 мс; единичный импульс; U_R=0 В;
Блокирующие параметры					
U_{RRM}	Повторяющееся импульсное обратное напряжение	В	6200...6500	$T_{j\,min}$< T_j <$T_{j\,max}$; 180 эл. град. синус; 50 Гц	
U_{RSM}	Неповторяющееся импульсное обратное напряжение	В	6300...6600	$T_{j\,min}$< T_j <$T_{j\,max}$; 180 эл. град. синус; единичный импульс	
U_R	Постоянное обратное напряжение	В	0.6·U_{RRM}	T_j=$T_{j\,max}$	
Тепловые параметры					
T_{stg}	Температура хранения	°C	–60...+55		
T_j	Температура p-n перехода	°C	–60...+150		
Механические параметры					
F	Монтажное усилие[1)]	кН	70.0...90.0		

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обозначение и наименование характеристики		Ед. изм.	Значение	Условия измерения	
Характеристики в проводящем состоянии					
U_{FM}	Импульсное прямое напряжение[1)], макс	В	1.85	T_j=25 °C; I_{FM}=6300 А	
$U_{F(TO)}$	Пороговое напряжение, макс	В	0.90	$T_j=T_{j\,max}$; $0.5\,\pi\,I_{FAV} < I_T < 1.5\,\pi\,I_{FAV}$	
r_T	Динамическое сопротивление[1)], макс	мОм	0.190		
Блокирующие характеристики					
I_{RRM}	Повторяющийся импульсный обратный ток, макс	мА	300	$T_j=T_{j\,max}$; $U_R=U_{RRM}$	
Тепловые характеристики					
R_{thjc}	Тепловое сопротивление p-n переход-корпус[1)], макс	°C/Вт	0.0050	Постоянный ток	Двухстороннее охлаждение
$R_{thjc\text{-}A}$			0.0150		Охлаждение со стороны анода
$R_{thjc\text{-}K}$			0.0075		Охлаждение со стороны катода
Механические характеристики					
m	Масса, макс	г	497		

МАРКИРОВКА

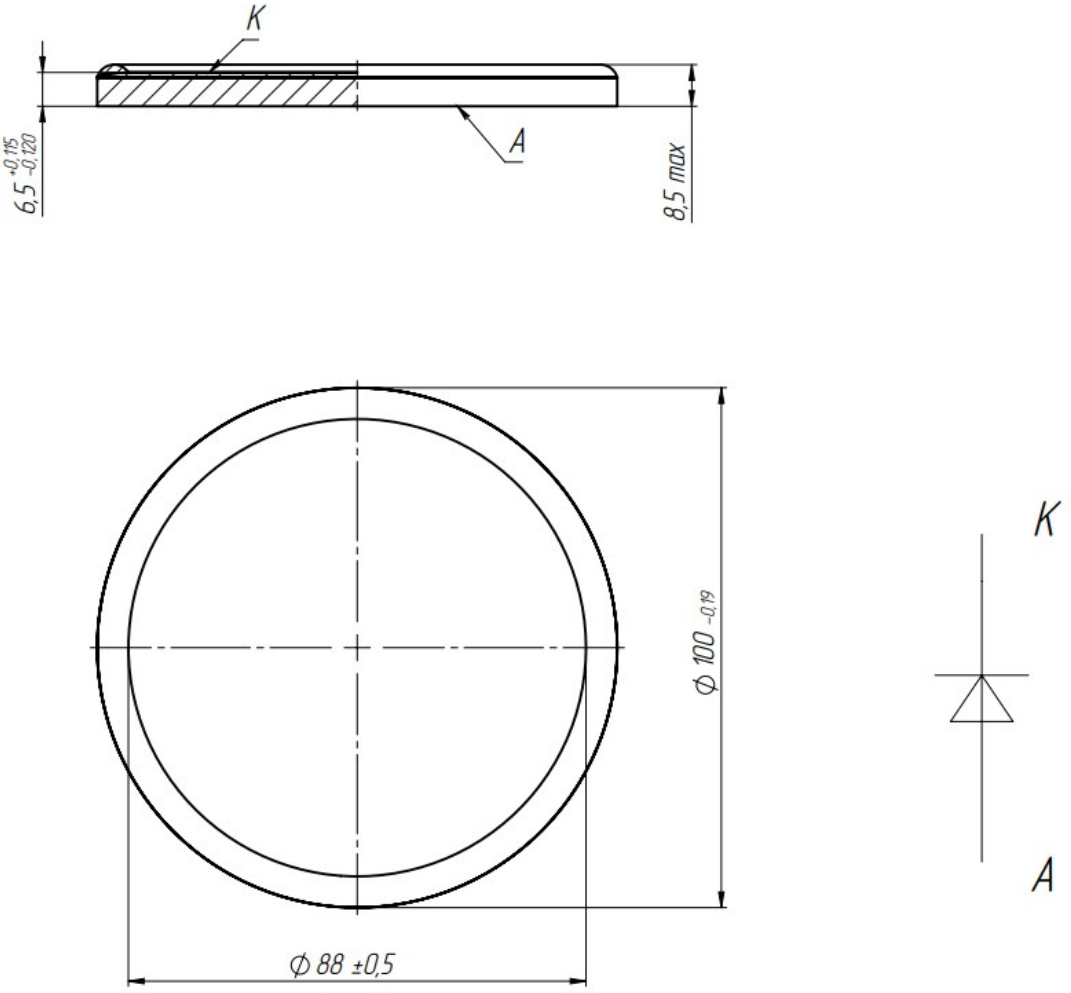
DR	100	3200	65
1	2	3	4

1. ППЭ Низкочастотного Диода
2. Максимальный диаметр, мм
3. Средний прямой ток, А
4. Класс по напряжению

ПРИМЕЧАНИЕ

[1)] В зависимости от характеристик применяемого корпуса. Указанные значения актуальны при использовании корпуса Протон-Электротекс D.G1.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



Все размеры в миллиметрах

Содержащаяся здесь информация является конфиденциальной и находится под защитой авторских прав.
В интересах улучшения качества продукции, АО «Протон-Электротекс» оставляет за собой право изменять информационные листы без уведомления.